2SC1060, 2SC1061

シリコン NPN 三重拡散形

低周波電力増幅用

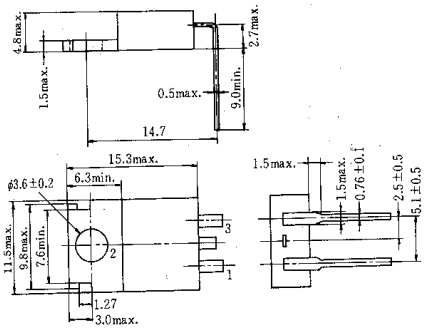
2SA670, 2SA671 とコンプリメンタリペア

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SA670 and 2SA671

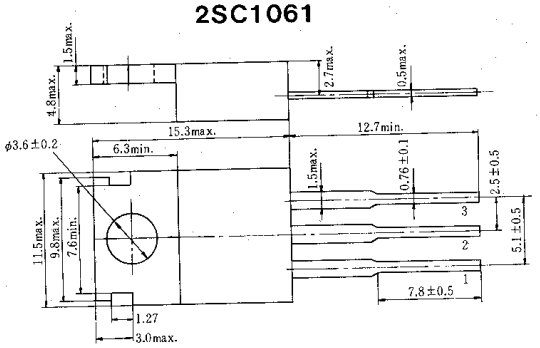
2SC1060



1. ベース：Base
2. コレクタ：Collector (フランジ) (Flange)
3. エミッタ：Emitter

(Dimensions in mm)

2SC1061



(JEDEC TO-220AA)

(JEDEC TO-220AB)

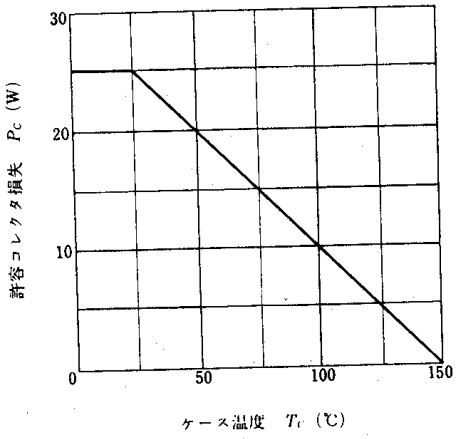
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SC1060, 2SC1061	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	50	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	50	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	4	V
コレクタ電流	I_C	3	A
許容コレクタ損失	P_C*	25	W
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150	℃

* T_C=25℃における許容値
* Value at T_C=25℃

許容コレクタ損失のケース温度による変化

MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=5mA, I_E=0	50	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=50mA, R_{BE}=∞	50	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=5mA, I_C=0	4	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=20V, I_E=0	—	—	100	μA
直流電流増幅率	h_{FE}*	V_{CE}=4V, I_C=1A	35	—	320	
直流電流増幅率	h_{FE}	V_{CE}=4V, I_C=0.1A	35	—	—	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	V_{CE}=4V, I_C=1A	—	0.85	1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=2A, I_B=0.2A	—	0.5	1.0	V
2次破壊電流	I_M	V_{CE}=40V, f=50Hz (Half Wave)	2.0	—	—	A
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=4V, I_C=0.5A	—	8	—	MHz

* 2SC1060, 2SC1061はh_{FE}の値により下記のように4区分し，現品に表示してあります。
* The 2SC1060 and 2SC1061 are grouped by h_{FE} as follows.

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
35～70	60～120	100～200	160～320